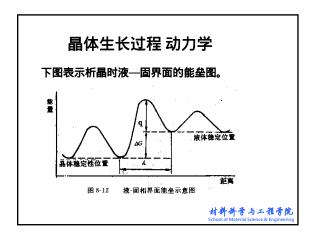
### 第二十三讲 晶体生长过程动力学

主讲:张骞

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering



- ・ 从固相到液相的迁移率应为:  $dn_{s\rightarrow l}/dt = fS\upsilon_0 exp[(-\Delta G_a V\Delta G_v) \ / \ kT]$
- 质点由液相向固相迁移的速率:
  dn<sub>l-x</sub>/dt=fSv<sub>0</sub>exp(-ΔG<sub>a</sub>/kT)
- 粒子从液相到固相的净速率为:

$$\begin{split} \frac{\mathrm{dn}}{dt} &= \frac{\mathrm{dn}_{1 \to \mathrm{s}}}{\mathrm{dt}} - \frac{\mathrm{dn}_{\mathrm{s} \to 1}}{\mathrm{dt}} = f S \boldsymbol{\nu}_0 \left[ \exp \left( -\frac{\Delta G_a}{kT} \right) - \exp \left( -\frac{\Delta G_V}{kT} \right) \right] \\ \frac{\mathrm{dn}}{dt} &= f S \boldsymbol{\nu}_0 \exp \left( -\frac{\Delta G_a}{kT} \right) \left[ 1 - \exp \left( -\frac{V \Delta G_V}{kT} \right) \right] \end{split}$$

材料科学与工程学院

式中提附加因子,是指当晶体界面的所有位置不能 都有效地附上质点时,能够附上质点的位置所占的分数。 (值的大小随生长机构的不同而异。

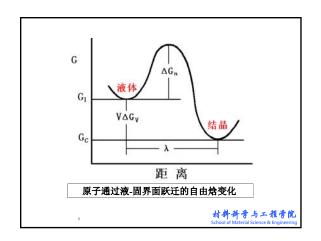
- 1、当位冷度很大时,热力学推动力大,二维空间晶核的临界尺寸很小,晶体表面的任何位置都能生长, 因子之值近于1;
- 2、当很小时,促T的函数,并随着生长的机构而变,f 因子和温度的关系,可用螺旋位错生长的机构来解释。

材料科学与工程学院

晶体线性生长速率u等于单位时间迁移的原子数目除以界面原子数S,再乘以原子间距 ,得 $(V-G_V=-G)$ 

$$u = f\left(\frac{\lambda}{S}\right) S v_0 \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{V\Delta G_v}{kT}\right)\right]$$

$$u = f\lambda v_0 \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) \left[1 - \exp\left(-\frac{V\Delta G_v}{kT}\right)\right]$$



讨论:

当过冷程度很小时, $V\Delta G_{V}$ < $\langle \mathbf{k} \mathbf{T}$ ,生长速率简化为

$$u = -f\lambda v_0 \exp(-\frac{\Delta G_a}{KT}) \frac{\Delta S \Delta T}{KT}$$

可知,由熔点或液相线温度开始降温时,随温度降低,晶体线生长速 离增加

当过冷度很大时, $V\Delta G_{V}$  >>kT,生长速率简化为

$$u = f\lambda v_0 \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{kT}\right) = \frac{fD}{\lambda}$$

可知,晶体生长速率受原子通过界面扩散速率所控制,温度降低时, 晶体线生长速率下降。

材料科学与工程学院

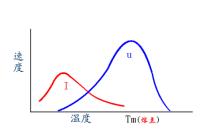
#### 结论:

生长速率u与扩散有关。

- 1)温度越低,扩散系数越小,生长速率也就越小,并趋于 零。所以当过冷度大,温度远低于平衡温度Tm时,生长速 率是扩散控制的,温度升高,生长速率增加;
- 2) 当温度接近于Tm时,扩散系数变大,这时,u值主要决定于两相的自由焓差 G ,温度升高,生长速率降低;
- 3) 当T=Tm时, G=0, u=0。

因此,生长速率在低于T<sub>m</sub>的某个温度,会出现极大值。 不过,这个温度总是高于具有最大成核速率的温度。

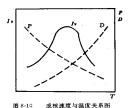
> 材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering



成核速度I与生长速度u随温度的变化

图7 成核速率I与生长速度u随温度的变化(Tm为熔点)

材料科学与工程学院 School of Material Science & Engineering 开始时它随着过冷度增加而增加,并成直线关系增至最大值后,生长速率下降。这与下图的晶核形成速率与过冷度的关系相似,只是其最大值较晶核形成速率的最大值对应的过冷度更小而已。



材料科学与工程系统

## 三、总的结晶速率

- 总的结晶速度常用结晶过程中已经结晶出晶体体积 占原来液体体积的分数和结晶时间的关系来表示。
- 假如将一物相 $\alpha$ 快速冷却到与它平衡的新相 $\beta$ 的稳定区,并将维持一定的时间t,则生成新相的体积为 $V_{\beta}$ ,原始相余下的体积为 $V_{\alpha}$

$$\alpha$$
相 β相  $t=0$  V 0  $t=\tau$  V <sub>$\alpha$</sub>  = V-V <sub>$\theta$</sub>  V <sub>$\theta$</sub> 

材料科学与工程学院

在dt时间内形成新相的粒子数N<sub>z</sub>,为:

 $N_{\tau}{=}I_{\nu}V_{\alpha}dt$  在dt时间内,新相 $\beta$ 形成的体积 $dV_{\beta}$ 等于在dt内 形成新相 $\beta$ 的颗粒数 $N\tau$ 与一个新相 $\beta$ 颗粒体积 $V_{\beta}$ 的 乘积,即:

$$dV_{\beta}{=}V_{\beta}{\cdot}N\tau$$

经过t时间:  $V_{\beta}=4/3\pi r^3=4/3\pi(ut)^3$ 则  $dV_{\beta}=V\beta\cdot N\tau=4/3\pi u^3t^3$  Iv  $V\alpha$  dt 相变初期 $V_{\alpha}\approx VdV_{\beta}\approx 4/3\pi VI_{\nu}u^3t^3$  dt

- · 在t时间内产生新相的体积分数为:  $V_{B}/V = 4/3\pi \int_{0}^{t} I_{v} u^{3} t^{3} dt$
- $V_{\beta}/V=4/3\pi I_{v}u^{3}\int_{0}^{t}t^{3}dt=1/3\pi I_{v}u^{3}t^{4}$
- · 阿弗拉米(M. Avrami)校正得:  $V_{\rm g}/V = 1 - \exp (-1/3\pi u^3 t^4 I_{\nu})$
- 克拉斯汀(1. W. Christion)进一步修正得:  $V_B/V=1-exp(-Kt^n)$

其中,K是包括新相核形成速率及新相的生长速度的系数,n 通常称为阿弗拉米指数

材料科学与工程学院

析晶过程是由晶核形成过程和晶粒长大过程所共 同构成的。这两个过程都各自需要有适当的过冷

高温亚稳区

4、两個仍形区建业辖区。尚温业辖区, 无晶核;(磁温压稳区,晶体生长速率两曲线的 重叠区通常称为"析晶区"。 若ΔT大,控制在成核率较大处析晶, 易得晶柱多而尺寸小的蛔晶; 苦ΔT小,控制在生长速率较大处析晶。

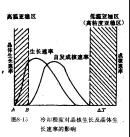
则容易获得晶粒少而尺寸大的粗晶;

图8-15 冷却程度对晶核生长及晶体生 长速率的影响

材料科学与工程学院

两曲线重叠而容易析晶。

要使自发析晶能力大的熔体 形成玻璃,采取增加冷却速度以 迅速越过析晶区的方法,使熔体 来不及析晶而玻璃化。



材料科学与工程学院

#### 五、影响析晶能力的因素

・1、熔体组成

相界线、低共熔点附近,不易析晶。

材料科学与工程学院

## •2.熔体的结构

- (1) 熔体结构网络的断裂程度。网络断裂愈多,熔 体愈易析晶。能修补网络的降低析晶趋势。见下 表。
- (3)添加中间体熔体析晶能力减弱。
- (2) 电场强度较大的网络变性体离子, 容易积聚析 晶。

材料科学与工程学院

#### Na,O-SiO,系统熔体的析晶能力

玻璃成分	SiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O•2SiO <sub>2</sub>	Na <sub>2</sub> O•SiO <sub>2</sub>	2Na <sub>2</sub> O•SiO <sub>2</sub>
R=O/Si	2	2.5	3	4
相应晶体 结构状态	骨架	层状	链状	岛状
结晶能力	难	易析晶,保温 1h表面结晶	极易结晶,保 温1h全析晶	不成玻璃

- 3. 界面情况 存在两相界面如分相、气泡等, 析晶容易。
- 4. 外加剂

材料科学与工程学院

## 液-液相变过程

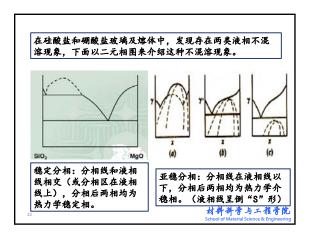
材料科学与工程学院

## 液相的不混溶现象(玻璃的分相)

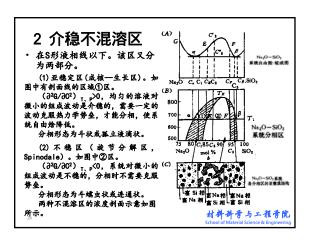
很长一段时间,人们都认为玻璃是均匀的单相物质,随着分析技术的进步,人们逐渐发现,在某些情况下,玻璃内部存在着不均匀性,玻璃存在分相现象。首先是在硼硅酸盐玻璃中发现的,组成为75%SiO<sub>2</sub>20%B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、5%Na<sub>2</sub>O玻璃,在500°C、600°C范围内进行热处理,使一个均匀相的玻璃分成了两个截然不同的玻璃相,一相几乎是纯的SiO<sub>2</sub>,另一相是富含B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和Na<sub>2</sub>O的玻璃相,这种玻璃经酸处理后,可得到含有4-15nm微孔的纯SiO<sub>3</sub>玻璃。

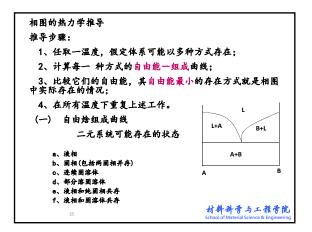
一个均匀的玻璃相在一定的温度和组成范围内有可能分成两个互不溶解或部分溶解的玻璃相(或液相),并相互共存的现象称为玻璃的分相(或称液相不混溶现象)。

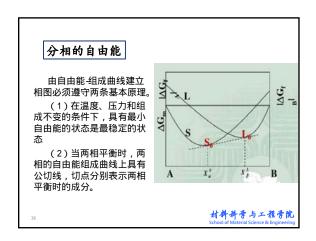
材料科学与工程学院

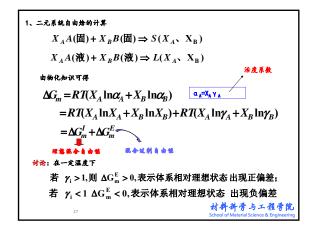


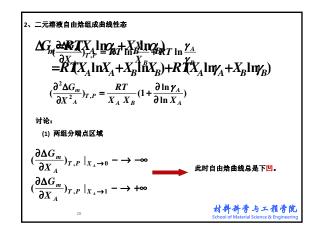
#### 

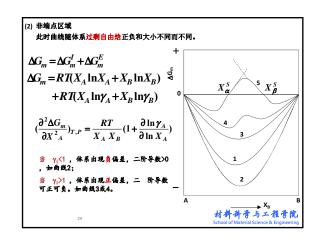


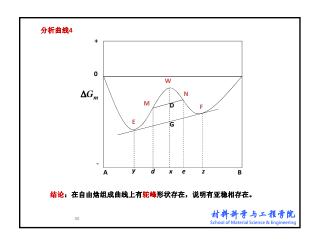












# (二)、自由焓-组成曲线相互关系的确定 1、计算任一温度下系统中可能出现各相自由焓组成曲线, 2、确定在同一自由焓 - 组成坐标中的位置关系; 3、根据系统自由焓最低原理与相平衡化学位相等原则,确定 各相间的平衡关系。 | AGra | |∆G<sub>fB</sub> ΔGm 材料B科学与工程学院

#### (三)、从自由焓组成曲线推导相图举例

A: (固态部分互溶相图)

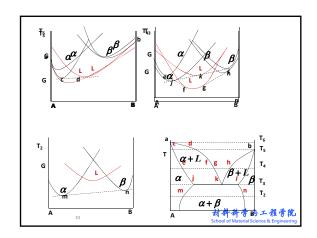
1、体系每一相都有一条自由能曲线,每条曲线曲线有一对应方程,此相有一定位置,在一定温度、压力下,会根据其自由焓大小,判断是否存在,若其自由焓最低,表示为最稳定相;

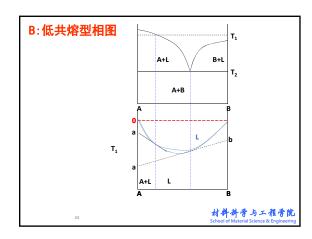
2、两条自由焓组成曲线不相交,表示在某温度下只有单相存

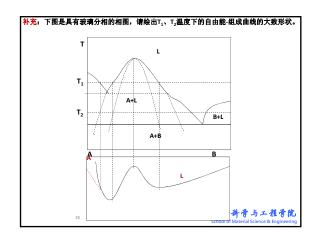
3、若幽线相交,必然存在一条公切线,两个切点组成表示在 此温度下平衡相的组成点;

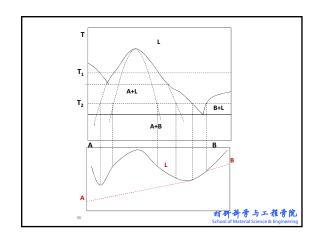
4、若曲线相交,则在交点处,表示同组成的两相的相平衡;

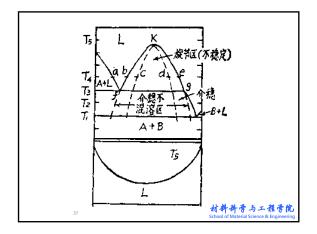
5、三条自由焓组成曲线<mark>依次相交</mark>,存在两条公切线,有两对平衡线,切点对应组成分别表示其平衡相组成; 6、三条自由能组成曲线,只有一条公切线,三个切点对应组成表示三个平衡相组成。

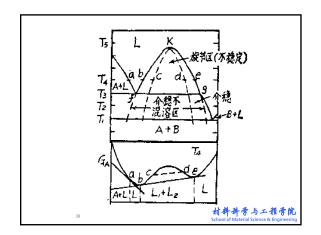


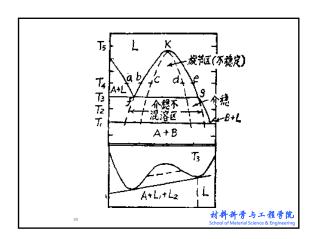


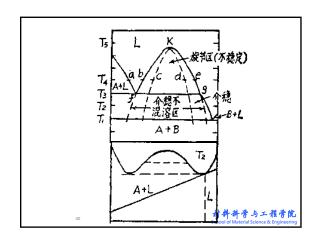


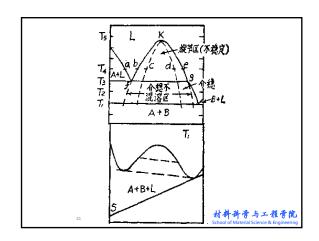


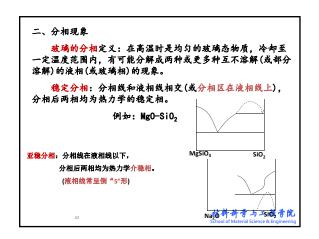


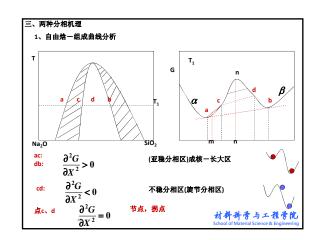


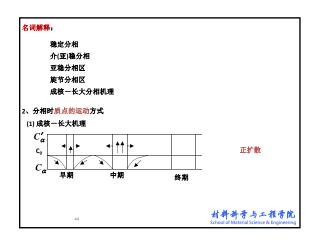


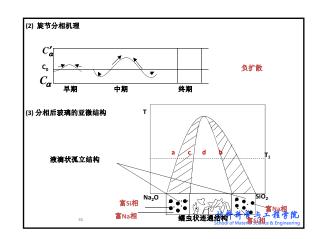


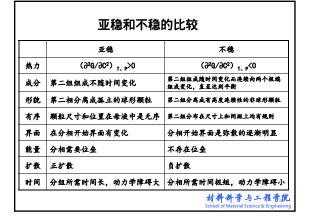


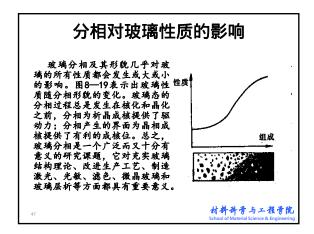












# 二、分相的结晶化学观点

- ・ 其它金属离子R叶与S計争夺氧离子,形成富硅相和富R相 (用离子电势Z/r表示)。
- · Z/r>1.4,产生稳定不混熔区,如Mg<sup>2+</sup>、Ca<sup>2+</sup>等;
- Z/r=1-1.4, 亚稳分相, 液相线趋于水平或呈倒S形, 如Na\*、Ba<sup>2+</sup>等;
- Z/r<1.0, 不发生分相, 如K+、Cs+等。
- · 见表8—4。

	离子电势和液相曲线的类型						
_	阳离子	Z	Z/r	曲线类型			
	Ca <sup>+</sup> Rb <sup>+</sup> K <sup>+</sup>	1 1 1	0. 61 0. 67 0.75	近似值			
_	Na+ Li+ Ba <sup>2+</sup>	1 1 2	1. 02 1.28 1.40	S形线			
_	Sr <sup>2+</sup> Ca <sup>2+</sup> Mg <sup>2+</sup>	2 2 2	1. 57 1.89 2.56	不混溶			
材料持常与工程景貌 School of Material Science & Engineering							